

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอน และ ความหนาแน่นพลาสมา ของพลาสมาอาร์กอนที่ได้จากการดิสชาร์จด้วยคลื่นวิทยุ ใน 챔เบอร์พลาสมาแบบกึ่งปิด	
ชื่อผู้เขียน	นายนิรุต ศุสดี	
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	รศ.ดร.กฤษพัฒน์ วัลย์ทอง รศ.ดร.บัณฑิต ณ ลำพูน ผศ.ดร.บรรจบ ยศสมบัติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทคัดย่อ

การวัดอุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่นพลาสมาของพลาสมาอาร์กอนที่ผลิตได้จาก
ระบบผลิตพลาสมาแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz โดยเทคนิคหัววัด Langmuir
และ optical emission spectroscopy เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการเคลือบฝังวัสดุด้วยพลาสมา
จากการทดลองที่ความดันก๊าซในช่วง 0.5-3.0 mTorr และแปรค่ากำลังคลื่นวิทยุระหว่าง 10-250 W
พบว่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่นพลาสมาที่หาได้จากเทคนิคแรกมีค่าอยู่ในช่วง 2.8-4.0
eV และ $0.1-1.3 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ตามลำดับ ส่วนอุณหภูมิอิเล็กตรอนที่หาได้จากเทคนิคที่สองโดยใช้แบบ
จำลอง local thermodynamic equilibrium จะมีค่าประมาณ 0.4 เท่าของค่าที่ได้จากเทคนิคแรก นอก
จากนั้นยังพบว่าอุณหภูมิอิเล็กตรอนจะลดลงและเพิ่มขึ้นกับความดันก๊าซและกำลังคลื่นวิทยุที่เพิ่ม
ขึ้นตามลำดับ ส่วนความหนาแน่นพลาสมาจะเพิ่มขึ้นกับทั้งความดันก๊าซและกำลังคลื่นวิทยุที่เพิ่ม
ขึ้น

Thesis Title	Measurement of Electron Temperature and Plasma Density in RF-Discharged Argon Plasmas in Multicusp Plasma Chamber	
Author	Mr. Nirut Pussadee	
M.S.	Physics	
Examining Committee	Assoc. Prof. Dr. Thiraphat Vilaithong	Chairman
	Assoc. Prof. Dr. Bundit Na-Lamphun	Member
	Asst. Prof. Dr. Banchob Yotsombat	Member

ABSTRACT

The measurement of the electron temperature and the plasma density of Argon plasma which is generated from the RF inductive discharge at 13.56 MHz are described using the technique of Langmuir probe and the optical emission spectroscopy. The experimental data will be used in the process of plasma immersion ion implantation. The electron temperature and the plasma density obtained at the gas pressure ranging between 0.5-3.0 mTorr and RF power ranging from 10 to 250 W show that the electron temperature and plasma density measured from the Langmuir probe technique is 2.8-4.0 eV and $0.1-1.3 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, respectively. The electron temperature obtained from the second technique using local thermodynamic equilibrium model is about factor 0.4 compare to the first one. In addition, the electron temperature decreases with increasing gas pressure, but increases proportional to the RF power. The plasma density increases with both gas pressure and RF power.